CLIPPEDIMAGE= JP403137504A

PAT-NO: JP403137504A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03137504 A

TITLE: ULTRASONIC SYSTEM FOR MEASURING FILM THICKNESS

PUBN-DATE: June 12, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TODA, KATSUYUKI KINOSHITA, TAKESHI MIYAJIMA, TAKESHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

ELECTRIC POWER DEV CO LTD N/A

KAIHATSU DENKI KK N/A

HITACHI CONSTR MACH CO LTD N/A

APPL-NO: JP01275346

APPL-DATE: October 23, 1989

INT-CL (IPC): G01B017/00

US-CL-CURRENT: 73/632

ABSTRACT:

PURPOSE: To measure a film thickness by applying an FFT processing

03/17/2003, EAST Version: 1.03.0002

on an echo

reception signal obtained by a transmission pulse containing pulse components

of low and high frequencies and by normalizing one of two peak values on the

low/high frequency side obtained from the data obtained through processing,

with the other of the values used as a basis.

CONSTITUTION: An ultrasonic probe 13 of large damping being used, an ultrasonic

transmission pulse containing pulse components of frequencies being low and

high is emitted and the ultrasonic wave is made to invade into bodies (15, 14)

to be inspected. A reception signal of a surface echo or an underside echo

obtained from the bodies is subjected to Fourier transform (FFT), a first peak

value and a second peak value higher than the first are obtained in the data

obtained through the FFT processing, and based on a value obtained by normalizing one of the two peak values with the other used as a basis, the

thickness of the coating film 14 is measured. By this system, the thickness of

plating or the like can be measured easily by the ultrasonic wave irrespective

of whether the body to be inspected is located inside or outside.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-137504

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)6月12日

G 01 B 17/00

Z 8304-2F

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全10頁)

公発明の名称 超音波膜厚測定方式

②特 頭 平1-275346

②出 頭 平1(1989)10月23日

⑩発 明 者 戸 田 勝 之 東京都中央区銀座6丁目15番1号 電源開発株式会社内 ⑩発 明 者 木 下 毅 東京都千代田区九段北4丁目2番5号 開発電気株式会社

内 内

⑩発 明 者 宮 島 猛 茨城県土浦市神立町650番地 日立建機株式会社土浦工場

内

⑪出 願 人 開発電気株式会社 東京都千代田区九段北4丁目2番5号

⑪出 願 人 日立建機株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番2号

個代 理 人 弁理士 梶山 佶是 外1名

明細構

- 1. 発明の名称 超音波膜厚測定方式
- 2.特許讃求の範囲
- (2) 正規化した値は、第1のピーク値に対する第 2のピークの値の割合であることを特徴とする讃 求項1記載の超音波膜厚測定方式。

- (3) 正規化した値は、第1のピークのdB値から第2のピークのdB値を引いたdB差であって、測定する被検体と同様な試験片について被覆された膜の厚さと前記dB差との関係を実測した特性グラフ又はこれに対応するテーブルに基づき前記被覆された膜の厚さを測定することを特徴とする請求項1記載の超音波膜厚測定方式。
- (4) 表質両に母材よりも超音波を量の大き組音波を関いたといるとのはないのでは、からは、ないのではないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないので

これに対応するテーブルに基づき前記メッキ屋の 厚さを測定することを特徴とする両面のメッキ母 さについての超音波膜厚測定方式。

(5) 表面側と内面側とに母材よりも超音波減度量 の大きなメッキ別を有する被検体のメッキ別の以 さを紐育波により測定するものであって、ダンピ ングの大きい超音波探触子を使用して周波数のパ ルス成分と高い周波数のパルス成分とを含む送信 超音波パルスを放射し、前記波換体に超音波を役 入させて前記被検体から得られる底面エコーの受 信信号をフーリエ変換し、このフーリエ変換した データにおいて低い周波数の側の第1のピーク値 とこれより高い周波数の側の第2のピーク値とを 得て、第1のピーク値と第2のピーク値とのdB差 を求め、測定する被検体と同様な試験片について メッキ厚さと前記dB差との関係を実測した特性グ ラフ又はこれに対応するテーブルに基づき表面側 及び内面側の前記メッキ層の厚さを求め、前記表 而のメッキ層の厚さを別の手段により測定して前 記表面側及び内面側のメッキ層の厚さから測定し

た前記表面のメッキ層の厚さを引くことにより前記内面側のメッキ層の厚さを得ることを特徴とする内面側のメッキ厚さについての超音被膜厚測定方式。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、超音波膜厚測定方式に関し、詳しくは、構築物に使用されているメッキされた鉄骨 材や鋼管の内側のメッキ厚さを測定してその腐食 状態を知ることができるような超音波による内側 面メッキ厚さの測定方式に関する。

[従来の技術]

外気に晒される状態にある鉄件材や鋼管等を使用した構築物では、腐食防止のために通常それらにメッキが施されている。このメッキは、麦面側あるいは中側などの内側而にも行われている。特に、鉄塔とか、鉄橋などのように主として鉄件材や鋼管を材料として組立てられる構築物に使用される部材は、たえず風雨に晒される鉄製の部材が多く、その長年に夏る耐久性を

保障するために内側にまで亜鉛等のメッキが施されているのが普通である。

[解決しようとする課題]

このような鉄製の構造物にあっては、その安全性や信頼性を維持し、管理する上で構成部材のメッキの品質やその経年変化を定期的に検査することが必要であって、その表面側(端出面側)の質食状態は目視観察することなどで比較的容易に分かる。また、メッキの表面の厚さや質食状態は、 従来からある電磁誘導法や渦電流法、光、レーザ等による表面検査方法等を用いて調べることも可能である。

しかし、表面から隠れている内側のメッキの状態を目視観察することはできない。 また、内面側のメッキの状態についての測定方法はないのが現状である。 特に、ほぼ密閉状態にある鋼管などにあっては、長年の問風雨に晒された結果、継ぎ目部分などから水や塩水が浸透して内部に入り、内側のメッキ層や母材までも侵食される。 そこで、そのような箇所を知るために部材の内部の状態を

この発明は、このような従来技術の問題点を解 決ずるものであって、内側外側にかかわらず超音 被によりメッキ度を等の膜度を容易に測定するこ とができる超音波膜厚測定方式を提供することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

このような目的を達成するためのこの発明の超音被膜厚測定方式の構成は、表面側又は底面側が段射よりも超音波減量の大きな膜で被概された被検体の被型膜の厚さを超により測定するものであって、ダンピングの大きい超音被探触であるで、ダンピングの大きないが、超音を分からであって、ブンを使用して超数のパルスを検が、が、のでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないのでは、このでは、このでは、このでは、このでで、必要ない。

をしたデータにおいて第1のピーク値とこれより高い周波数の第2のピーク値とを得て第1のピーク値及び第2のピーク値の一方を基準として他方を正規化した値に基づき被超級の厚さを測定するものである。

[作用]

したがって、低い周波数のパルス成分と高い周

放数のパルス成分とを含む送信パルスにより得られたエコー受信信号にFFT処理をし、FFT処理されたデータに対して低い周波数側の第1のピーク値とを採取して一方を他方の基準として正規化することで膜 厚に関する測定データを得ることができ、膜厚の 測定が可能になる。

[実施例]

以下、この発明の一実施例について図面を参照 して詳細に説明する。

第1図は、この発明を適用した一実施例の組音 被検査装置のプロック図であり、第2図(a)は、 1000のダンピングがなされている15MHz のプローブで超音液を放射した場合の送信超音波 被形の説明図、第2図(b)は、そのフーリエ変 換した周被数分布の説明図、第3図(a)は、底 面側に亜鉛メッキした場合のメッキ層の厚さの測 定状態の説明図、第3図(b)は、底面側に亜鉛 メッキした数額板について超音波測定で得られる その底面エコー受信信号をフーリエ変換して得た

周波数分布とメッキ厚さとの関係の説明図、第4 図は、2つのピーク値の差とメッキ厚さとの関係 を示す特性の説明図、第5図は、メッキ厚さを測 定する場合の超音波検査装置の処理のフローチャ ート、第6図は、両面にメッキされた鋼管等の測 定状態の説明図である。

さて、第1図において、20は、携帯型の超音 波検査装置であって、1は、その探傷器部である。 この探傷器部1は、パルサー・レシーバ等から構 成され、送信端子11からプローブ13にパルス 信号を送り、エコー受信信号を受信端子12で受 けてそれを増幅し、アナログ信号としてA/D変 換回路2に出力する。

プローブ 1 3 は、ここでは、100 Qのダンピングがなされている15 M H z のプローブで超音波を放射した場合の送信超音波の波形を示すのが第2図(a)であり、ダンピングが大きいことから通常のパルス信号より歪みが大きく、低い周波数成分を多く含むパルス部分 T 1 とこれより高い周波数成分を多く含むパルス部分 T 2 とが含まれ

第1図に戻って説明すると、A/D変換回路2は、探傷器部1から得られる送信波、表而反射被(表面エコー)、欠陥反射波(欠陥エコー)、底面反射波(疾陥エコー)等についての各アナログ信号を、例えば、50MHz(周期=20ns)程度の高い周波数でサンブリングする。そして、サンプリングしたこれらのアナログ出力をデジタル値に変換してマイクロブロセッサ(MPU)5が処理できる入力データ値としてバス13に送出する。

なお、ここでは、表面エコー、欠陥エコー、底面 エコー等のうち特に底面エコーを採取する。

バス13には、ゲインダイヤル、カーソルダイヤル等を有するダイヤル式数値設定回路3とシートキーを有するキー人力回路4とが接続されていて、マイクロプロセッサ5は、これら回路からバス13を介してダイヤルにより設定される設定値及び各種のキー人力信号を受ける。

そこで、ゲインダイヤルにより探傷器部1に対するゲイン設定値(調整値)が入力されると、マイクロプロセッサ5は、探傷器部1の高周波増幅器のゲイン(増幅率)を制御し、ゲインダイヤルにより入力されたゲイン設定値に対応するゲインになるように高周波増観器のゲインを設定する。

8は、バス13に接続されたRAMであり、A /D変換されたエコー受信信号についてのデジタ ルデータとROMカードによりロードされた各種 のアプリケーション処理プログラムと人力キーに より指定された探傷モードを示すフラグ等の各種 の情報やデータが格納されていて、さらに、画像 表示データをピット展開して記憶する画像メモリ 部 6 1 が設けられている。また、第 4 図に示すような特性のグラフに対応するデータをテーブル化して記憶したメッキ厚さ特性テーブル 8 a を有している。

7は、ROMであり、これにはマイクロプロセッサ5が実行するエコー受信信号のデジタル値をRAM8の所定領域に転送する処理プログラムやROMカードからのプログラムをRAM8の所定領域に転送する処理プログラム、そして表示処理プログラム71等の各種の基本プログラムが記憶されている。

8は、ROMカードインタフェースであって、 装置に装着されるROMカードとコネクタにより 着脱できる関係で接続され、マイクロプロセッサ 5の制御に応じてFFT処理プログラム等を搭載 するROMカードに記憶されたFFT処理プログ ラム等をバス13に送出する。なお、MPU5は、 ROMカードが装着されたときにそこに記憶され たプログラム等を読出してRAM8のそれぞれの

プログラムを格納する領域にそれぞれをロードす る処理をする。

9は、RS-232C インタフェースであり、外部の情報処理装置(特に、そのマイクロプロセッサ)とデータ交換をするための回路である。

10は、LCD表示装置であって、エコー受信信号の画像等のほか、FFT処理をされた被化を表示し、カーソル指定での画面人力機能をするとピデオメモリインタフェーラ、被品駆動回路、モレデオメモリコンととフィーラ、被品駆動回路、モレーカスが、128×256ドット等のドットフィクスの被これでいる。

ここで、RAMBには、メッキ厚さ特性テーブルBaのほかに、FFT減算プログラムBbと、 周波数分布特性出力処理プログラムBc、両而人 力処理プログラムGd、メッキ厚さ算出処理プロ グラムBe等とが格納される領域が設けられ、測 定の際にFFT被算プログラム6bはじめとする これらプログラムがROMカードから転送される。

FFT減算プログラム8bは、RAM8の所定 領域に記憶されたエコー受信信号(デジタル値) に対してFFTの減算処理をしてその結果をRA M8のデータ領域に記憶し、周波数分布特性出力 処理プログラム8cを起動する。

周波数分布特性出力処理プログラム8cは、前記のFFTの演算結果データを読出してそれを周波数分布表示画案データとして展開し、画像メモリ部61に記憶して表示処理プログラム71を起動する。その結果、この画案データが画像メモリ部81からLCD表示装置10のビデオメモリに伝送されてエコー受信号の周波数分布特性出力を表示される。この表示の後に周波数分布特性出力処理プログラム6cは画面人力処理プログラム6

両面入力処理プログラム B d は、エコー受信信号の周波数分布の表示画面上において、例えば、マウスカーソルによりオペレータが指定した 2 つ

のピーク位置 P_1 、 P_2 (第3図(a)、(b)参照、ただし、 P_1 は P_2 より低い周放数)についてピーク値 P_1 、 P_2 (ただし、FFT されたデータのdB値)を画面上で指定された座標値に基づきFFT データから抽出して、それをRAM6のパラメータ記憶エリアの P_1 、 P_2 の位置に再込み、メッキ呼さ算出処理プログラムG e を起動する。

キを施した特性であり、22bは、板厚12mmの 炊鋼板に対して厚さ130 µmでの同様な特性、 22cは、板厚12mmの炊鋼板に対して厚さ21 0μmでの同様な特性である。なお、これらの特 性は、それぞれの特性において5MHz前後の低 い周波数側の第1のピークP1の値が一致するよ うに減度性のおおきなエコー受信信号(厚いメッ キ周) については、そのFFT処理データに対し て縦方向(出力=dB)側スケールを拡大した形で 表示している。 雪い換えれば、厚さ30μmで亚 鉛メッキを施した特性の第1のピークP」にそれ 以外の他の特性の第1のピークPLの値を一致さ せて正規化し、それぞれの特性の第2のピークP 2 の値がどの程度となっているかを、第1のピー ク値に対する第2のピーク値の割合(%)として 表示している。

この特性で分かるように、10MHz前後の第 2のピークP2の値P2は、厚さに応じて減駐量が大きくなるような変化が見られる。そこで、底面エコー受信信号のFFT値として得られる第2 第3図(b)は、第2図(a)に示すダンピングなされたプローブの送信波で第3図(a)に示すように底面側に数十一数百μm程度で重鉛メッキ14を施した厚さ12㎜の飲鋼板15を超音波探傷してその底面エコーの受信信号を採取し、それをFFT処理して画面上に表示した場合の周波数分布結果である。

一般に、亜鉛あるいは亜鉛メッキ層は、鋼板(母材)よりも超音波の減度量が大きいので、前記 のようにメッキ層が薄くても高い周波数での減度 量は、低い周波数での減度量よりもあきらかに大 きく、底面エコーはメッキ14の厚さに影響され た被形となる。

すなわち、このグラフにおいて22aは、仮厚 12mmの軟鋼板に対して厚さ30μmで亜鉛メッ

のピークP2 の値 P2 を第1のピークP1 の値 P1 で割って正規化すれば、底面側での亜鉛のメッキ灯さの測定が可能である。

ところで、第2図の(a)に示すように、送信 放形自体にも第1のピーク値と第2のピーク値と の間に Δ h の 差がある。したがって、これらの 差 値自体は、送信被に影響され、これとの相対的な 関係にある。そのため 第4図に示す特性グラフ1 7 をテーブル化して 用いる。この特性グラフ17 は、測定時と同じ送信 放形においてメッキ 厚さ t に対応する 深さの 傷を その 底面 につけた 所定 の 厚 さの 試験 片を 測定し、 前記 差値 Δ h と メッキ 厚さ t との 関係を 測定したものである。

すなわち、この第4図はメッキ厚さを測定する ために試験片を測定した一例であって、これは、 実施例に対応してプローブのダンピング特性を1 00Ωとし、規定された電圧の送信パルスを発生 して規定された15MHzのプローブを駆動して 切た底面エコーをFFT処理をし、この底面エコー受信信号のFFTデータ(dB値)に対して第1 のピークのところの値及び第2のピークのところの値の差(= Δ h) とメッキ厚さ t との関係についてメッキ厚さ t (傷の深さ d) が既知の試験片を実測した特性である。

次に、底面エコーを採取してFFT処理をした データにより前記の方法で双面側のメッキ厚さを 測定する処理について第5図に従って説明する。

はNO条件が成立してその入力キーに対応する他の測定処理となり、メッキ厚さ測定キーが入力されたときには、ここでYES条件が成立して次のステップ④へと移る。

ステップ®では、ROMカードからメッキ厚さ特性テーブル6aと、FFT演算プログラム6b、周波数分布特性出力処理プログラム6c、画面入力処理プログラム6d、メッキ厚さ算出処理プログラム8e等の読込み処理が行われる。

まず、勿5図のステップ①において、装置を探 傷モードに設定するために探傷モードの機能キー をキー入力回路4から入力する。次のステップ② において、この人力情報を受けてROM7に記憶 された所定の処理プログラムが起動されてマイク ロプロセッサ5がそれを実行し、ゲインがダイヤ ル式数値設定回路3のゲインダイヤルにより設定 され、測定条件や測定範囲等がキー入力回路4の キーによりオペレータ(測定者)から入力される。 その結果、これら人力情報とROM7に記憶され た処理プログラムによってマイクロプロセッサ5 が動作してその制御により探傷器部1の利得がゲ インダイヤルに従って設定され、装置自体の保傷 機能が生ずる。なお、このときの測定条件の1つ としてここでは底面エコーを採取するようにゲー ト位置が設定される。

次のステップ③では、超音波探傷において判定 基準となるメッキ厚さ測定処理を行うか否かを、 人力される機能キーにより判定する。ここで、所 定のメッキ厚さ測定キー以外のキーが入力されれ

グがなされたプローブ13に加えられ、第2図(a)に示すような送信波形でプローブ13が駆動 される。それに応じて得られる軟鋼板(被検体) からの底面エコーをプローブ13が受けてそのエ コー受信信号がゲートに応じて採取され、それが A/D変換されてROM7に記憶された基本プロ グラムに従ってMPU5によりRAM8に転送さ れて記憶される。

次に、ステップので、FFT演算プログラム8 もが起動され、MPU5により実行されて採取された底面についてのエコー受信信号に対してFFTの演算処理が行われ、その結果がRAM6に記憶される。

次のステップ®では周波数分布特性出力処理プログラム6cが起動され、MPU5により実行されてLCD表示装置10の順而上に底面のエコー受信信号をフーリエ変換した周波数分布画像が表示され、画而入力処理プログラム8dが起動される

ステップ③では、表示された周波数分布画像に

対してオペレータがカーソルにより2つのピーク P1 、 P2 の位置を指定する処理が行われる。 2 つのピークの位置が順次指定されると、画面入力 処理プログラム B d がカーソルで指定された位置の座標データに基づきFFTのデータから2つのピーク値(最大値) P1 、 P2 (dB値)を得て、メッキ原き算出処理プログラム B e を起動する。

次のステップ®では、メッキ厚さ算出処理プログラム6eにより前記の2つのピーク値Pi, P2のデータから登値Δhが算出され、それに基づきメッキ厚さ特性テーブルβaが参照されてメッキ厚さが求められ、それがRAM6に記憶されるとともにLCD表示装置10に表示される。

ステップ⑪では、繰り返し測定するか、終了かが人力回路4からのキー人力により判定され、測定終了の機能キーがオペレータから入力されないとき(これ以外のキーのとき)にはステップ⑤へと戻って前記と同様な測定処理が繰り返される。なお、ここで、終了キーが入力されればこの処理は終了する。

チで制定し、この測定に応じて自動的に位置を読込んでもよい。そして、この測定位置対応に表現合計のメッキ厚さの測定データをRAM6に記憶する。

次に、従来からの電磁誘導法や渦電流法、光、レーザ等による表面検査方法を用いて前記の位は、対応に鋼管17の表面のメッキ原さの測定をして、そのデータを他の測定装置あるいはホストコンとュータ等の情報処理装置からRS-232C インタフェース9を介してRAM6に転送する。ここで、先に採取した底面エコーによるメッキ厚さから表面検査方法による表面のメッキ厚さを位置対応に発出する。

なお、この場合、知音放検査装置20のRAM 6に記憶した位置とメッキ厚さとのデータを他の コンピュータ等に入力し、ここで従来の表面検査 万法で測定したメッキ厚さを引いて内面側のメッ キ厚さを求める演算処理をしてもよいことはもち ろんである。 ところで、前記の測定処理においては、ステップののFFT被算プログラム等の続込み処理は、ステップの装置を探傷モードに設定する前に行ってもよいことはもちろんである。

以上は、災面側にメッキされた部材の測定処理であるが、没貨両面にメッキされている場合には、前記の測定は没貨の合計のメッキ厚さになる。すなわち、没災のメッキ厚さを測定する場合も前記と同様に底面エコーを採取するが、組音波が表面のメッキ層を通過するので底面エコーの特性は表質面のメッキ厚さを加えたものとなる。

そこで、第6図に部分断面図として示す鋼管 17のように内面にメッキされている場合の内面側のメッキ 17aの部分の厚さを測定する場合について次に説明する。

内側のメッキ厚さを測定する場合には、前記の第5図の処理を行い、まず、表要合計のメッキ厚さを鋼管17の位置データ(プローブ13の走査距離)とともに採取する。この位置データは、測定の都度、キーボードから入力しても所定のビッ

ところで、この例では、表面のメッキ厚さを表面のメッキ厚さを探収することなく、、後ののでは、変面検査をはない。 というのはない、というのはない、というのはない。 ないないのはないのであるにはプローブの大きさで超音を超いるのははからである程度決まり、それがある範囲をもののであるでは、少年をものであるというとない。 少年をものであるにはいいないによりにないがいましいがらればないのであるというにはないのであるというにはないのであるというにはないのである。

以上のようにしてメッキ厚さが測定できれば、例えば、たえず風雨に晒される鉄製の部材の内側のメッキ厚さが測定でき、それにより腐食状態を知ることができる。なお、腐食状態の測定に当たっては、メッキ膜さが最初の強襲状態のばらつき(例えば、メッキ膜型100μm程度で±40μm程度のばらつき)の範囲を超えて薄くなっているところが腐食により供食されているとする。さ

らに、メッキ財さがほとんどない状態では、メッキ財を越え、母材まで侵食されていると判定する ことができる。

以上説明してきたが、実施例では亜鉛メッキを 鉄材に施した例を挙げている。しかし、これは一 例であって、メッキは錫等のメッキであってもよい。また、メッキされる側は樹脂やセラミックス 等であってもよい。要するに減度量の大きな被型 脳を有する材料であればよい。したがって、この 発明における被型層はメッキに限定されるものではない。

実施例では、底面又は内側面についてのメッキ 厚さについて説明しているが、この発明は、表面 だけのメッキあるいは被種層であってよく、被猫 層は2つの部材の境界面のようなところであって もよい。なお、この境界面は、手前の部材では底面 値であり、次の部材では表面となるので表面又は 底面の測定にこれらは含められる。

実施例では、第1のピーク値を基準として第2

ローブで超音液を放射した場合の透信超音液液形の説明図、第2図(b)は、そのフーリエ変換した周波数分布の説明図、第3図(a)は、第3図に延鉛がある。。第2回の関係を放射のでは、第3図にの関係の関係を受ける。第3図では、第3図にの関係を受ける。第3図では、第3回の関係の関係を受ける。第4回の説明図では、第5回の説明図である。第6図は、ある。

1 … 超音放探傷器部、 2 … A / D 変換回路、 3 … ダイヤル式数値設定回路、 4 … キー入力回路、 5 … マイクロブロセッサ(M P U)、 6 … R A M、 6 a … メッキ厚さ特性テーブル、 6 b … F F T 演算プログラム、 6 c … 周波数分布出力処理プログラム、 6 e … メッキ厚さ類出処理プログラ

のピーク値を第1のピーク値で割って正規化した 値を求めているが、これは、逆に、第2のピーク 値を基準として第1のピーク値を第2のピーク値 で割って正規化した値を求めてもよい。なお、こ のような場合には、第4図の特性グラフもそれに 対応させるとよい。

[発明の効果]

以上の説明から理解できるように、この危明にあっては、低い周波数のパルス成分とを高い周波数のパルス成分とを高い周波数のパルスでは、FFT処理をして、FFT処理をして低対して低い周波数側の第1のピーク値と高い周波数側の第2のピーク値と高い周波数側の第2のピークを他方の基準として正規化ができるので、膝厚の測定が可能になる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、この発明を適用した一実施例の超音 被検査装置のブロック図、第2図(a)は、10 0Ωのダンピングがなされている15MH2のブ

ム、 7 ··· R O M 、 8 ··· R O M インタフェース、 9 ··· R5 - 232C インタフェース、

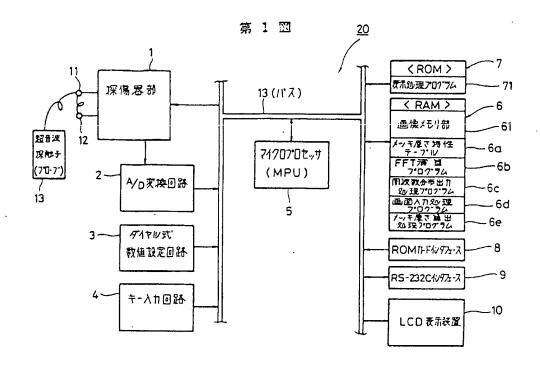
10…被品汲示装置(LCD表示装置)、

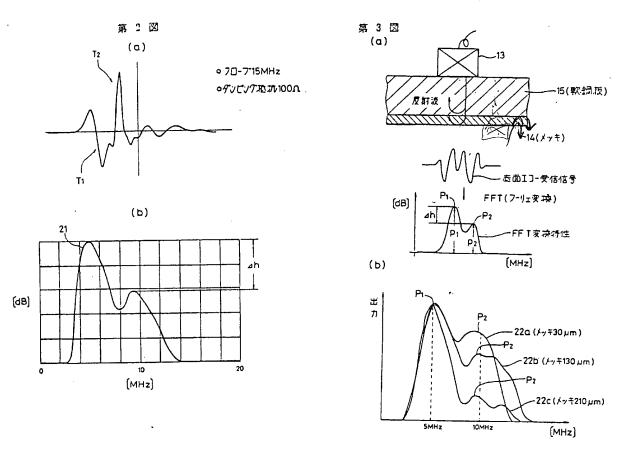
20…携帯型の超音波検査装置、

21…送信波形のフーリエ変換特性のグラフ、

特許出願人 谜 额 明 免 株 式 会 社 明 発 電 気 株 式 会 社 日 立 健 機 株 式 会 社

代理人 弁理士 梶 山 倩 是 弁理士 山 本 富士男





-29-

